

SICAS 統計の 2005 年第 4 四半期 (10 - 12 月) の数値公表

SICAS 統計(世界半導体生産キャパシティ統計)の 2005 年第 4 四半期(10 - 12 月)の数値がまとまったので公表いたします。生産能力の数字は断りのない限り 8 インチウエファー換算の数字です。

2005 年第 4 四半期(4Q)の MOS 計の生産能力は 1538.2 千枚/週で前四半期(2005 年 3Q)の 1482.9 千枚/週から+3.7%増加した。前期比伸長率は 2005 年 1Q に+3.0%、2Q に+1.7%、3Q に+3.9%と堅調に増加したが 4Q もそれを継続した。4Q の前年同期比伸長率は+12.8%であった。4Q の μ (ミクロン)別の生産能力前期比伸長率は、0.7 μ 以上が-0.3%、0.4 μ 以上 0.7 μ 未満が+0.3%、0.3 μ 以上 0.4 μ 未満が-0.1%、0.2 μ 以上 0.3 μ 未満が+4.8%、0.16 μ 以上 0.2 μ 未満が-1.6%であった。SICAS では 2005 年 1Q から 0.16 μ 未満を「0.12 μ 以上 0.16 μ 未満」と「0.12 μ 未満」に細分し始めたが、4Q の 0.12 μ 以上 0.16 μ 未満は 284.6 千枚/週で前期比伸長率+2.4%、0.12 μ 未満は 426.2 千枚/週で前期比伸長率+12.2%であった。全体としては、特に 0.12 μ 未満のプラス伸長が顕著であった。

μ (ミクロン)別の 4Q の稼働率は、0.7 μ 以上が 87.0%(前期比+2.7%)、0.4 μ 以上 0.7 μ 未満が 88.4%(同+0.2%)、0.3 μ 以上 0.4 μ 未満が 85.6%(同+0.6%)、0.2 μ 以上 0.3 μ 未満が 85.2%(同-0.1%)、0.16 μ 以上 0.2 μ 未満が 91.4%(同+4.2%)、0.12 μ 以上 0.16 μ 未満が 97.6%(同+1.7%)、0.12 μ 未満が 98.9%(同+1.7%)であった。この結果 MOS 計では 3Q の 90.7%から+1.9%増加し、92.6%となった。

MOS 計に占めるファンダリー・ウェハの生産能力(4Q)は 264.2 千枚/週であり、3Q に対して前期比+2.9%の伸長を示した。4Q の稼働率は 94.9%であり、3Q から+3.2%増加した。MOS 計に占める 8 インチウエハの生産能力は 984.5 千枚/週であり、3Q に比べ+0.4%増加した。SICAS では 2004 年 1Q から 12 インチ(300mm)ウエハの統計を集計しているが、2005 年 4Q の生産能力は 8 インチ換算で 288.7 千枚/週(12 インチ実枚数では 128.3 千枚/週)と 3Q から+11.3%の伸張を示し、稼働率は 97.6%(前期比+4.9%)であった。(諸データの詳細は別添をご参照ください。)

SICAS は 1995 年 2 月 24 日に発足し、世界の 5 業界団体 (EECA、JEITA、KSIA、SIA、TSIA) の支援の下に、現在世界の主要半導体(IC)メーカ 40 社が会員として参加しています。

- EECA : European Electronic Component Manufacturers Association (欧州電子部品工業会)
- JEITA : Japan Electronics & Information Technology Industries Association (電子情報技術産業協会)
- KSIA : Korea Semiconductor Industry Association (韓国半導体産業協会)
- SIA : Semiconductor Industry Association (of the US) (米国半導体工業会)
- TSIA : Taiwan Semiconductor Industry Association (台湾半導体産業協会)

SICAS に参加している IC メーカは、年 4 回、四半期毎に、その IC 生産能力と実投入数を地域別に委託した第三者のデータ集計機関に提出し、そこで集計された数値は最後に中央集計機関によりまとめられ、世界計の集計データとなり発表されます。

データの秘密保持のため、会員を含むいかなる関係者(データ集計機関を除く)も、公表される「世界計のデータ」以外を知り得ない仕組みとなっています。

参加会員は、各々自社の世界全体の生産能力と実投入数を連結ベースで把握し報告しますが、他の IC メーカーに生産委託している部分は含みません。生産能力・実投入数のいずれもウェハ枚数を単位とし、集計期間内の総数を適当な平均値に換算し「千枚/週」の単位で報告します。報告方法は以下のとおりです。

MOS IC は、加工精度により 0.7 ミクロン以上、0.4 ミクロン以上 0.7 ミクロン未満、0.3 ミクロン以上 0.4 ミクロン未満、0.2 ミクロン以上 0.3 ミクロン未満、0.16 ミクロン以上 0.2 ミクロン未満、0.12 ミクロン以上 0.16 ミクロン未満、および 0.12 ミクロン未満に分けて 8 インチウェハの枚数に換算、バイポーラ IC は加工精度の分類はなく、5 インチウェハの枚数に換算。また MOS IC 生産能力のうち 8 インチウェハと 12 インチウェハの生産能力および実投入数のデータも併せて集計。また生産能力については、1 年 = 52 週、1 週 = 7 日、1 日 = 24 時間の稼働を前提とします。

SICAS への参加は任意であり、いかなる IC メーカー(5 つの支援業界団体のどれにも属さないメーカーも含む)に対してもオープンです。四半期毎に公表される SICAS 統計は、参加会員だけでなく誰にでも入手可能であり、前述の 5 業界団体から入手できます。また、**SICAS 統計は、全ての過去データを含め以下の Web サイトでご覧になることができます。**

<http://www.sicas.info/>

SICAS の運営組織は会員から選出された代表者で構成されており、現在、事務局はオランダに設置されています。

SICAS 統計は、世界の IC 生産能力とその稼働実績に関する信頼に足る情報をタイムリーに提供するものであり、このような情報は、IC 製造設備の急速な技術革新や IC 技術の各世代毎に必要な設備投資額が肥大化していることなどを考えると、半導体及び関連産業にとって有用な参考情報であると考えられます。

なお、日本地域の運営組織として、SICAS Japan が 1995 年 1 月に設立されました。

お問い合わせ先：SICAS Japan

事務局長 和泉 正

TEL: 045-832-7762

FAX: 045-832-7752

e-mail: t-izumi@c3-net.ne.jp